

**Отзыв научного руководителя о научной деятельности соискателя ученой степени
кандидат физ.-мат. наук Левина Романа Викторовича**

Левин Р.В. в 2004 году поступил в аспирантуру Южно-Российского государственного технического университета и был прикомандирован в ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН в лабораторию «Фотоэлектрических преобразователей», зав. Андреев В.М. После окончания аспирантуры в 2007 году продолжил работу последовательно в НТЦ Микроэлектроники РАН (инженер –исследователь) и ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН (стажер-исследователь, инженер, научный сотрудник).

Область научной работы Левина Р.В. «Разработка технологии изготовления гетероструктур на основе антимонида галлия» методом газофазной эпитаксии из МОС. К началу работ такие исследования в России не проводились. Левин Р.В. освоил работу на новой установке газофазной эпитаксии из МОС, экспериментально подобрал оптимальные условия выращивания антимонида галлия, т.к. технологические режимы не описываются в статьях, и разработал технологию изготовления наногетероструктур практически во всем диапазоне изменения ширины запрещенной зоны твердых растворов изопериодных к антимониду галлия. Выполнен большой объем исследовательских и технологических работ. Им предложены новые, защищенные патентами РФ, решения актуальных проблем технологии и конструкции оптоэлектронных приборов.

За время работы Левин Р.В. проявил себя инициативным, целеустремленным, исполнительным и ответственным работником, настойчивым и изобретательным исследователем способным самостоятельно ставить и решать возникающие перед ним задачи. Он способен руководить молодыми сотрудниками и организовать их на решение поставленных задач. Являлся руководителем 3 бакалаврских, 4 магистерских работ студентов.

Можно сказать, что из него сформировался высококвалифицированный специалист в области технологии полупроводников.

В настоящее время Левин Р.В. работает в ФТИ им.А.Ф.Иоффе в должности научного сотрудника. Он является соавтором более 40 работ и 3 патентов РФ по теме диссертации. Принимал участие в конференциях и совещаниях с докладами, участвовал в работах по грантам РФФИ, Миннауки и президиума РАН.

Научный руководитель
кандидат физ.- мат. наук

Пушный Б.В.

Ученый секретарь ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Доктор физ.- мат.наук

Шергин А.П.